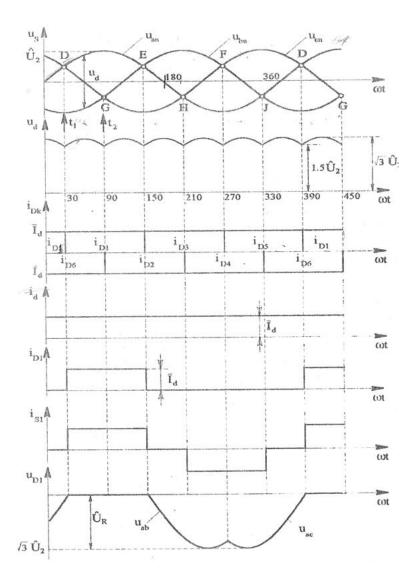


Partea de forță a redresorului trifazat în punte necomandată



Formele de undă pentru funcționarea redresorului trifazat

#### Tema de proiectare

Se va proiecta un redresor trifazat in punte necomandat cu urmatoarele date nominale:

- 1. Tensiunea de alimentare primara  $U_1 = 6 kV$ ;
- 2. Curentul mediu redresat nominal

$$I_{dn}$$
=400 + n · 40=400 + 5 · 40 = 600 A;

3. Tensiunea medie redresata la curent nominal in sarcina

$$\overline{U}_{dn}$$
=300 + n · 100=300 + 5 · 100 = 800V

- 4. Frecventa f=50Hz;
- 5. Conditii de suprasarcina clasa F
- 6. Temperatura mediului ambiant  $T_a = 40 \, ^{\circ}C$

Unde "n" este numarul de ordine individual indicat de cadrul didactic indrumator

Valoarea medie a tensiunii redresate este:

$$\overline{U}_{dn} = \sqrt{3} \cdot \widehat{U}_s \cdot \frac{6}{\pi} \cdot \sin \frac{\pi}{6}$$

unde  $\widehat{U}_s$  este valoare de vârf a tensiunii de alimentare pe fază. Valoarea de varf a tensiunii de alimentare pe faza se calculeaza cu relația

$$\widehat{U}_S = \frac{\overline{U}_{dn}}{1.65398} = \frac{800}{1.65398} = 483.67$$

Rezistența sarcinii se consideră egală cu  $R_s = \frac{\overline{U}_{dn}}{\overline{I}_{dn}} = \frac{800}{600} = 1.3 \Omega$ 

# Alegerea diodei

Alegerea diodei se face astfel incat sa nu fie depasiti doi parametri:

- curentul direct mediu maxim  $I_{FAVM}$ ;
- tensiunea repetitiva inversa maxima  $V_{RRM}$ ;

Stabilirea curentului direct mediu maxim (nominal) pentru dioda

Conform functionarii studiate la etapa precedenta dioda este parcursa de un curent de forma dreptunghiulara cu unghiul de conductie  $\Theta$ =120° electrice (o treime de perioada) si de amplitudine  $I_d = \Gamma_{dn} = 600$  A. Aceasta inseamna ca valoarea medie a curentului care parcurge dioda va fi

$$\bar{I}_{FAV} = \frac{\bar{I}_{dn}}{3} = \frac{600}{3} = 200$$
A

Dioda va fi aleasa astfel incat

$$\bar{I}_{FAV} \geq \frac{\bar{I}_{FAV}}{c_i};$$

$$I_{FAV} \ge \frac{200}{0.9}$$

$$\Gamma_{FAV} \ge 222.2 \text{ A};$$

unde  $0.6 \le c_i \le 0.9$  coeficient de siguranta ce tine seama de locul in care va fi amplasat convertorul.

Se va alege  $c_i$ =0,9.

In cazul in care, in loc de o dioda, se monteaza mai multe diode in paralel va trebui tinuta seama si de potentiala neuniformitate a repartitiei curentilor prin cele  $n_p$  diode in paralel.

In cazul de fata se va alege o singura dioda.

Stabilirea tensiunii inverse repetitive maxime  $V_{RRM}$  pentru dioda

Conform functionarii studiate la etapa precedenta dioda este polarizata in invers cu o tensiune maxima  $\widehat{U}_{R=}\sqrt{3}\cdot\widehat{U}_{S}=\widehat{U}$ 

Valoarea medie a tensiunii la bornele sarcinii este

$$\overline{U}_{dn} = \overline{U}_{d0} = \widehat{U}\frac{p}{\pi}sin\frac{\pi}{6} = \widehat{U}\frac{6}{\pi}sin\frac{\pi}{6}$$

Deci

$$\widehat{U} = \frac{\overline{U}_{dn}}{\pi^{\sin{\frac{\pi}{6}}}} = \frac{800}{\pi^{\sin{\frac{\pi}{6}}}} = 837.74 \text{ V}$$

Notam  $V_{RM}=1$ ,  $1\cdot c_v\cdot \widehat{U}=1$ ,  $1\cdot c_v\cdot \widehat{U}=1843.05$ , unde  $c_v=2$ 

Iar dioda aleasa va trebui sa aiba  $V_{RRM} \ge V_{RM} \Rightarrow V_{RRM} = 2000 \text{ V}$ 

In urma calculelor si a valorilor obtinute, am ales dioda D325N2000.

# Calcul $P_{FAV}$ si verificare alegere dioda

Dioda aleasa este D325N si din catalogul acesteia am notat marimile

caracteristice:  $v_{T0} = 0.78 \text{ V}$ 

 $r_T = 0.00082 \ \Omega$ 

Calculul puterii medii dezvoltate in conductie in regim nominal pentru dioda

Conform functionarii studiate dioda este parcursa de un curent de forma dreptunghiulara cu unghiul de conductie  $\Theta$ =120° electrice (o treime de perioada) si de amplitudine

 $I_d = I_{dn} = 600 A$  . Aceasta inseamna ca:

-valoarea media a curentului care parcurge dioda este:

$$\bar{I}_{FAV} = \frac{\bar{I}_{dn}}{3} = \frac{600}{3} = 200 \text{ A}$$

-valoarea efectiva a curentului care parcurge dioda va fi:

$$I_{FRMS} = \frac{\bar{I}_{dn}}{\sqrt{3}} = \frac{600}{\sqrt{3}} = 346.41 \text{ A}$$

Puterea medie dezvoltata in conductie in regim nominal de dioda,  $P_{FAV}$ , va fi:

$$P_{FAV} = v_{T0} \cdot I_{FAV} + r_T \cdot I_{FRMS}^2$$

$$P_{FAV} = 0.78 \cdot 200 + 0.00082 \cdot 346.41^2$$

$$P_{FAV} = 254W$$

Dimensionarea sistemului de racire (radiatorului)

Stabilirea valorii rezistentei termice capsula-mediu ambiant ( $R_{thCA}$ ) necesare

Observație: am micșorat  $R_{thCA}$  pentru efectuarea calculelor și am fost nevoit să măresc lungimea radiatorului.

Se determina din fisierul "tabel.Rth.pdf" in functie de numarul de ordine n (n=5) si de dioda aleasa(D325N2000) valoarea  $R_{thCA} + \Delta r(\Theta)$ . Vom nota aceasta valoare cu

$$[R_{thCA} + \Delta r(\Theta)]_{tahel} = 0.2957 \text{K/W}$$

Pentru dioda aleasa (D325N2000), din catalogul de diode, din graficul  $\Delta r(\theta)$  pentru  $\theta$ =120 si forma de unda dreptunghiulara se determina  $[\Delta r]_{arafic}$ .

$$[\Delta r]_{qrafic} = 0.011 \text{K/W}$$

Se calculeaza valoarea rezistentei termice capsula-mediu ambiant  $R_{thCA}$  necesara. Vom nota aceasta valoare cu  $[R_{thCA}]_{nec}$ .

$$[R_{thCA}]_{nec.} = [R_{thCA} + \Delta r(\Theta)]_{tabel} - [\Delta r]_{qrafic} = 0.9*(0.2957-0.011) = 0.2562 \text{K/W}$$

### Alegerea radiatorului

Aceasta etapa presupune stabilirea unui profil de radiator si a unei lungimi corespunzatoare astfel incat acesta sa asigure o rezistenta termica capsula – mediu ambiant (o vom nota  $[R_{thCA}]_{radiator}$ ) mai mica decat cea necesara  $[R_{thCA}]_{nec.}$ 

Din fisierul "Catalog radiatoare.pdf" alegem un profil de radiator si o lungime corespunzatoare  $[L]_{radiator}$  in functie de necesarul stabilit in etapa precedenta.

Se recomanda ca radiatorul sa fie ales astfel incat

$$[R_{thCA}]_{radiator} \le 0.9 \cdot [R_{thCA}]_{nec.} \Rightarrow [R_{thCA}]_{radiator} \le 0.2562 \text{K/W}$$
  
 $\Rightarrow [R_{thCA}]_{radiator} \le 0.25 \text{ K/W}$ 

 $[R_{thCA}]_{nec.} = 0.2562 \text{ K/W}$  (de la etapa anterioara). Alegem un radiator tip KP0,4 cu lungimea de 135 mm( $[L]_{radiator} = 135 \text{ mm}$ ) care asigura o rezistenta termica capsula- mediu ambiant  $[R_{thCA}]_{radiator} = 0.25 < [R_{thCA}]_{nec.} = 0.2562 \text{ K/W}$ . Racirea în acest caz este naturală.

#### Verificarea diodei din punct de vedere termic

In timpul functionarii nu trebuie depasite temperatura virtuala maxim admisibila a jonctiunii  $T_{vJmax}$  si temperatura maxim admisibila a capsulei  $T_{cmax}$ .

Se calculeaza  $T_{vI}$  si  $T_C$  cu urmatoarele relatii:

$$T_{vJ} = T_a + P_{FAV} \cdot (R_{thJC\ DC} + \Delta r + R_{th\ CA})$$

$$T_C = T_a + P_{FAV} \cdot R_{th CA}$$

Unde:

Temperatura mediului ambiant  $T_a = 40 \, ^{\circ}C$ 

Puterea directa medie  $P_{FAV}$ =254W

Rezistenta termica jonctiune capsula  $R_{thICDC} = 0.1065 \text{ K/W}$ 

Corectia, functie de unghiul de conductie  $\Delta r$ =0.011

Rezistenta termica capsula-mediu ambiant  $R_{th CA} = 0.2957 \text{ K/W}$ 

$$\Rightarrow T_{vJ} = T_a + P_{FAV} \cdot (R_{thJCDC} + \Delta r + R_{thCA})$$

$$T_{vJ} = 40 + 254 \cdot (0.1065 + 0.011 + 0.2957)$$

$$T_{vJ} = 144.97^{\circ}C$$

$$\Rightarrow T_C = T_a + P_{FAV} \cdot R_{thCA}$$

$$T_C = 40 + 254 \cdot 0.2496$$

$$T_C = 115.10^{\circ}C$$

Determinarea temperaturii virtuale maxim admisibila a jonctiunii  $T_{vJmax}$  si temperaturii maxim admisibila a capsulei  $T_{Cmax}$ .

 $T_{vImax} = 150 \, ^{\circ}C$  data de catalog;

$$T_{cmax} = 120$$
°C;

 $I_{FAV} = 222 A$  din grafic rezulta ca  $T_{Cmax} = 120$ °C;

Verificarea diodei din punct de vedere termic

Daca  $T_{vJ} < T_{vJmax}$  si  $T_C < T_{Cmax}$  atunci calculul se considera incheiat.

$$\Rightarrow$$
144.97 °C < 150 °C (Adevarat)

$$\Rightarrow$$
115.10 °C < 120°C (Adevarat)

Calculul protectiilor la suprasarcina, scurtcircuit si supratensiuni

Date initiale:

- 1. Tensiunea la bornele instalatiei  $U_{n instal} = 400 \text{V}$ ;
- 2. Curentul mediu redresat nominal  $\bar{I}_{dn} = 800 \text{ A}$
- 3. Conditii de suprasarcina clasa F
- 4. Frecventa de lucru f=50Hz.

Alte date necesare:

- 1. Tensiunea inversa de varf, maxim admisibila la bornele circuitului  $V_{RM} = \sqrt{2} \cdot U_{n \; instal} = 565,69 \; V$
- 2. Inductivitatea totala a circuitului exterior  $L_s = 375 \mu H$ ;

## 3. Curentul prezumat de scurtcircuit $I_p = 5 \text{kA}$

Pentru dimensionarea protectiilor este nevoie de stabilrea unei diode, comune, pentru care se vor dimensiona aceste protectii. Se folosesc relatiile cunoscute de la etapele precedente:

$$\bar{I}_D = \frac{\bar{I}_{dn}}{3} = 266,67 A$$

$$I_D = \frac{\bar{I}_{dn}}{\sqrt{3}} = 461,88 A$$

$$\bar{I}_{FAVM} \ge \frac{\bar{I}_D}{0.5} \ge 533,34 A$$

$$V_{RRM} = 1400 \ge 2V_{RM} \ge 1131 \, V$$

Vom alege deci dioda D630N 1400

Calculul protectiilor la scurtcircuit si suprasarcina

- a) Stabilirea tensiunii nominale a sigurantei  $U_n \ge U_{n \, instal} = 400 \, V$
- b) Stabilirea curentului nominal al sigurantei

$$I_n \ge I_{DS} = \alpha_s \cdot \frac{\bar{I}_{dn}}{\sqrt{3}} = 1.5 \cdot 461.88 = 692.82 A$$

Alegem o siguranta cu tensiunea nominala  $(U_n)$  de 500 V si curentul nominal  $(I_n)$  de 700A.

c) Verificarea sigurantei la suprasarcina de scurta durata.

In cazul in care siguranta este parcursa de curentul de suprasarcina de scurta durata (300%, vezi conditii de suprasarcina clasa F) aceasta se va arde. Timpul dupa care se arde se numeste timp de prearc  $(t_{pa})$ . Se doreste verificarea faptului ca  $t_{pa}$  este mai mare decat timpul de suprasarcina de scurta durata (1 minut)

Se calculeaza curentul de suprasarcina de scurta durata:

$$I_{Dsd} = \beta \cdot \frac{\bar{I}_{dn}}{\sqrt{3}} = 3 \cdot 461,88 = 1385,64 A.$$

Cu aceasta valoare din diagrama reiese ca  $t_{pa} = 85 \text{ s} \ge 60 \text{ s}$ 

- d) Verificarea protectiei diodei la scurtcircuit
  - Curentul limitat de catre siguranta( $I_l$ ) trebuie sa fie mai mic decat curentul direct de suprasarcina accidentala la cald al diodei( $I_{FSM}$ )

Curentul limitat se determina din diagrama  $I_l(I_p)$ , pentru  $I_p$ =5kA data de proiectare

Pentru dioda D630N1400  $I_{FSM}$ =8,3 kA

Se verifica daca  $I_l(I_p)=7400A \le 8,3 \text{ kA}$ 

 Corelarea integralelor de curent (joule) ale sigurantei si diodei Pentru sigurantele montate in serie cu diodele trebuie verificata inegalitatea

$$K(I^2t)_{totala\ siguranta} < (I^2t)_{la\ cald\ al\ diodei} \Rightarrow K = 0.71$$
  
 $K(I^2t)_{totala\ siguranta} = 0.71 \cdot 75.597 = 53.67\ KA^2s$ ,

$$(I^2t)_{totala\ siguranta}$$
=75,597 K $A^2s$ , iar

 $(I^2t)_{la\ cald\ al\ diodei}$ =344,5 K $A^2s$  care verifica inegalitatea de mai sus

• Verificarea la tensiunea de arc

Pentru ca tensiunea de arc care apare la adresa sigurantei sa nu distruga dioda trebuie indeplinita conditia:

$$U_a \leq V_{RRM \ dioda}$$

$$V_{RRM\ dioda} = 1400\ V$$
  
 $U_a = 930 \text{V}$ 

Rezulta faptul ca inegalitatea de mai sus este verificata, deoarece  $930 \le 1400 \text{ V}$ .

# Calculul protectiilor impotriva supratensiunilor de comutatie

Aceasta protectie se realizeaza cu grupuri RC montate in paralel cu dioda. Relatiile de calcul sunt:

$$C = \frac{2Q_s}{V_{RM}} (\mu F)$$
, daca  $Q_s$  a fost introdus in  $\mu C$ .

R=
$$\sqrt{\frac{L_s}{C}}$$
, daca  $L_s$  a fost introdus in μH, iar C in μC.

 $P_R = 2 \cdot Q_s \cdot V_{RM} \cdot f \cdot 10^{-6}$  daca  $Q_s$  a fost introdusa in  $\mu$ C,  $V_{RM}$  in V Unde:

- $Q_s$  este sarcina stocata a diodei care se afla din caracteristica  $Q_s = f \cdot (\frac{-di}{dt})$  data in catalogul diodei;
- $V_{RM}$  este tensiunea inversa maxima care apare la bornele diodei  $V_{RM} = \sqrt{2} \cdot U_{n \; instal};$
- $L_s$  este inductivitatea totala a circuitului exterior  $L_s = 375 \mu C$

Panta curentului se calculeaza cu relatia:

$$-\frac{di}{dt} = \frac{V_{RM}[V]}{L_{S}[\mu H]} = \frac{565,69}{375} = 1,508 \approx 1,51 \left[\frac{A}{\mu S}\right]$$

de unde rezulta ca  $Q_s = 700 \mu C$ 

Va rezulta:

 $\Rightarrow$  C=2,47  $\mu$ F

 $R = 12,31\Omega$ 

 $P_R = 39,6 W$